

PSD PIN фотодетекторный чип — техническое описание

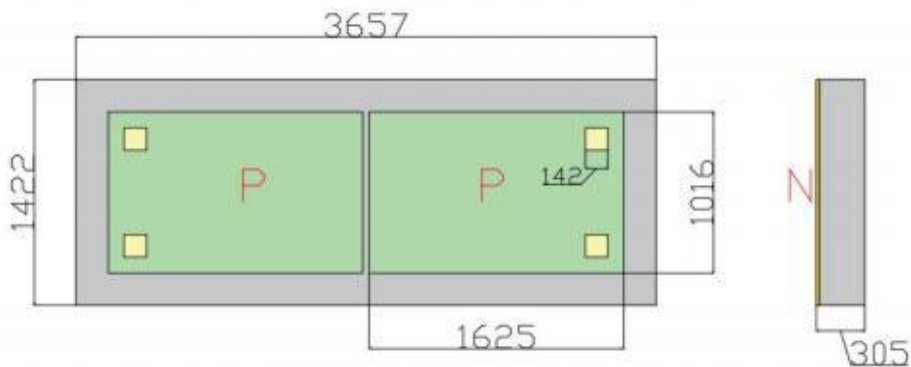
P/N : WS9F-01C

Применение

Si PIN фотодиодный чип

Структура

Планарная структура: PIN-диод;
электроды: задняя сторона (катод) — Au, верхняя сторона (анод) — Al



ГАБАРИТЫ

Габариты	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	1625 x 1016±20 x 2			мкм
Ширина чипа	3657			мкм
Длина чипа	1422			мкм
Высота чипа	290	305	320	мкм
Размер контактной площадки		142		мкм

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °С)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Прямое напряжение	Vf	If=10mA, H=0	0.5		1.3	В
Обратное напряжение	Vbr	Ir=100µA, H=0	35			В
Обратный темновой ток	Id	Vr=10V			10	нА
Рабочий диапазон длин волн	λ		400	940	1100	нм
Емкость	Cj	VR=5V, f=1MHz		22		пФ